PSIMチュートリアル

EMI 解析と EMI フィルターの設計

(EMI Design Suite)

Mywayプラス株式会社

1、概要

EMI デザイン・スイートは、パワー・エレクトロニクス・コンバータ・システム用の伝導 EMI 分析と EMI フィルタ設計のトータル・ソリューションを提供します。EMI デザイン・スイートは、 ユーザーが典型的なパワー・エレクトロニクス・コンバータ製品開発サイクルで実施されている EMI プリ・コンプライアンスの繰り返しを軽減するのに役立ちます。選択した EMI 規格に基づい て、デザイン・スイートは、ディファレンシャル・モード (DM) とコモン・モード (CM) の両方 の伝導・ノイズに対して適切な減衰を行う EMI フィルターを自動的に設計し、動作可能でシミュ レーション可能なシステムを生成します。

ユーザーがハードウェア実験から測定されたディファレンシャル・モード(DM)およびコモン・モ ード(CM) EMI データを提供できる場合は、デザイン・スイートを使用して EMI フィルターをす ばやく設計することもできます。

EMI フィルタ、ライン・インピーダンス安定化ネットワーク(LISN)、DM / CM EMI ノイズ信号ア ナライザなど、EMI 分析に不可欠な回路モデル、寄生コンポーネント、および回路ブロックを含 む EMI プリ・コンプライアンス・テスト・システムを迅速にまとめる機能を備えています。 EMI デザイン・スイートは、次の方法でエンジニアに大きなメリットと利点を提供します。

・システム・エンジニアが EMI を評価し、バス・バー(またはボードトレース)、半導体、ヒー トシンクなどの

主要なサブ・システム間の寄生インダクタンスと静電容量の影響を理解するのに役立ちます。 また、エンジニアがハードウェア開発を開始する前に詳細なハードウェア / 機械的レイアウ ト仕様の洞察を行い、EMIの観点からサブ・システム操作のより良い結果を得るのに役立ちま す。

- ・回路基板レイアウトを始める前に、ハードウェア・エンジニアが部品の選択と EMI フィルタの 設計を実行して、EMI 要件を満たすのに役立ちます。
- ・EMI エンジニアがシステムの EMI プリ・コンプライアンス・テストを迅速に実行するのに役立 ちます。

EMI デザイン・スイートは、EMI フィルタ開発を迅速に提供し、EMI プリ・コンプライアンス・ プロセスを大幅にスピードアップするのに役立ちます。 EMI デザイン・スイートには、5 種類のコンバータ設計テンプレートと EMI プリ・コンプライア ンス・セット・アップ用の1つの一般的な EMI 設計テンプレートが用意されています。

降圧コンバータ	CISPR-Class B EMI プリ・コンプライアンス 降圧コンバータ
昇圧コンバータ	Mil-461440V EMI プリ・コンプライアンス 昇圧コンバータ
力率改善コンバータ	FCC Class B EMI プリ・コンプライアンス PFCコンバータ
位相シフト・フル・ブリッジ('PSFB) DC-DC コンバータ	CISPR-25 レベル 4 EMIプリ・コンプライアンス PSFB dc-dcコンバータ
PSMS ドライブ	CISPR-25 レベル 3 EMIプリ・コンプライアンス PMSMドライブ
EMI 一般 設計	EMI 一般の設計テンプレート ユーザが

PSIM のパワー・エレクトロニクス・コンバータ・システムの一般的な EMI プリ・コンプライア ンス・セットアップは、EMI フィルタ、LISN、DM / CM EMI ノイズ信号アナライザ、CM 寄生容量 ブロック、および電力コンバータ・システムで構成されています。一般的な EMI テンプレートの 全体的な構造を以下に示します。



EMI 寄生パラメータと目的の X キャップ、Y キャップの容量値を指定すると、回路全体をシミュレーションして EMI 性能を調査する準備が整います。

このチュートリアルでは、EMI デザイン・スイートで EMI テンプレートを使用する方法について 説明します。 プロセスを説明するための例として、降圧コンバータのテンプレートを使用しま す。

降圧コンバータの要件は次のとおりです:

- ・入力電圧 Vin = 120Vac,
- ・出力電圧 Vo = 12Vdc,

⁰⁴⁴¹⁰_T9_109_EMI 解析と EMI フィルターの Page 3/14 設計 (EMI Design Suite)

- ・出力電力
- ・入力コンデンサ C_link = 500uF,
- ・出力インダクタ Lo = 53uH,
- ・出力コンデンサ Co = 6.5mF
- ・EMI コンプライアンス規定 : CISPR 22 Class B

P = 250W

- 寄生パラメータは次のように定義されます。
- ・直流入力コンデンサ
 等価直列抵抗 ESR = 20mΩ
- ・出力コンデンサ
 等価直列抵抗 ESR = 10mΩ
- ・パワー・スイッチ 等価直列インダクタンス ESL = 5nH
- ・バス・バー(又は基板パターン)の
- 等価直列インダクタンス ESL = 20nH
- 同相モード(CM)の寄生容量は次のように定義されます。
- ・C_cm1 = 500pF (出力のプラスとグランド間)
- ・C_cm2 = 500pF (出力のマイナスとグランド間)
- ・C_cm3 = 50pF (ダイオード D1 の カソードとグランド間)
- ・C_cm4 = 50pF (ダイオード D1の アノードとグランド間)
- ・C_cm5 = 100pF (MOSFET Q1 のドレインとグランド間)
- ・C_cm6 = 100pF (入力コンデンサのマイナスとグランド間)
- ・C_cm7 = 50pF (入力ラインとグランド間)
- ・C_cm8 = 50pF (入力ライン接地とグランド間)

シミュレーション用に入力された同相(CM)寄生容量の値は、実際の回路測定値(回路がすでに構築されている場合)または推定と過去の経験に基づく目標値(回路がまだ構築されていない場合) を反映する必要があるためです。EMI コンプライアンス・テストのシミュレーションのためには 意味があります。

レベル2 MOSFET モデルは、スイッチング過渡現象を考慮に入れるために MOSFET Q1 に使用され ます。

降圧コンバータは 100kHz のスイッチング周波数で動作します。スロープ補償付きのピーク電流 検出の内部ループが採用されています。 外部ループの電圧 PI 制御は、ピーク電流の内部ループ への電流基準を提供します。

EMI 設計プロセスを開始する前に、コンバータ回路(レベル 2 MOSFET または IGBT モデルを使用) が機能している必要があることに注意してください。これにより、コンバータ回路のスイ ッチング電源デバイスの di / di および dv / dt 特性を反映します。 EMI デザイン・スイートを使用した EMI 評価は、次の3つのステップで実行できます。: ・システムの寄生パラメータと EMI フィルタ・パラメータの定義。

・EMI フィルターを無効にしてシミュレーションを実行します。CM と DM の両方の周波数と振幅、 および CM と CM が EMI 標準を超える最悪のポイントでの EMI 標準レベルを記録して入力します。 ・EMI フィルターの設計を実行し、EMI フィルターを有効にしてシミュレーションを再実行しま

す。

ステップ 1:システムの寄生パラメータの定義

PSIMで、[Design Suites] >> [EMI Design Suite]に移動し、サンプル EMI 回路の 1 つ、たとえ ば Buck Converter (CISPR-22 Class-B) を選択します。以下のようなダイアログウィンドウが 表示されます。

[Unpack]をクリックして、ファイルをデフォルトのフォルダーに解凍します。別のフォルダに解 凍するには、[Change Folder]をクリックしてフォルダを参照するか、フォルダ名を入力します。 この例では、ファイルは「c:¥ temp」に配置されます。

Unpacking Package Files	×
Unpack the package file to the following fo	der: Change Folder
	Unpack Cancel

・ファイルが解凍されると、以下に示すようにテンプレート回路が PSIM に表示されます。左側のパラメータパネルから設計パラメータを入力または変更します。



04410_T9_109_EMI 解析と EMI フィルターの 設計(EMI Design Suite) 回路図の左側には、入力パラメータパネルがあります。パネルは、EMI フィルター関連パラメー ター(EMI フィルターの有効化/無効化、X-Cap および Y-Cap の容量値、CM インダクター・パラ メーターなど)、CM 寄生容量、および EMI フィルター減衰パラメーター(CM と DM 両方の最悪の 周波数と振幅と EMI 標準レベル)を定義します。

このステップでは、「コモン・モード EMI」および「ディファレンシャル・モード EMI」セクショ ンの値はまだ使用できないため、無視してください。これらは、ステップ II の実行の後に取得 することができます。

この例では、次のように値を入力します。

EMI Filter:		
EMI_filter_enable:	0	
EMI_filter_stage:	1	
Cx:	6.8u	
Cy:	100n	
K_leakage_cm:	0.05	
_R_cm:	0.1m	
Common-Mode EMI:		
Freq_cm_EMI:	200k	
Amp_cm_EMI:	81	
_Amp_cm_EMI_Std:	63.6	
Differential-Mode EMI:		
Freq_dm_EMI:	200k	
Amp_dm_EMI:	81.5	
_Amp_dm_EMI_Std:	63.6	
Common-Mode Capacitances:		
C_cm1:	500p	
C_cm2:	500p	
C_cm3:	50p	
C_cm4:	50p	
C_cm5:	100p	
C_cm6:	100p	
C_cm7:	50p	
C_cm8:	50p	

これらのパラメータの定義は、パラメータ・パネルの[Help]ボタンをクリックしてオンライン・ ヘルプで説明されています。

ステップ2: EMI フィルターを無効にしてシミュレーションを実行する

EMI フィルターを無効にして (EMI_filter_enable = 0) パラメーター・パネルにパラメータ ーを入力したら、[Design EMI Filter]ボタンをクリックして、回路図のパラメーター・ファ イル「"parameters - EMI.txt"」を更新します。このパラメータ・ファイルには、ユーザーが入 力した EMI パラメータと EMI デザイン・スイートによって計算されたパラメータが含まれてい ます。

パラメータパネルの EMI パラメータのいずれかが変更された場合、回路図の EMI パラメータ・ファイルを[Design EMI Filter]ボタンで更新する必要があります。

シミュレーションが完了したら、CM、DM、および EMI 信号を3つの別々のウィンドウに表示し、 [Analysis]メニューで FFT を実行します。X 軸の範囲を 100kHz に変更し、Y 軸のスケールを dB µV に設定します(または SIMVIEW で、[Options] >> [Default Display Settings]に移動し、 ["Y - Axis in dB uV after FFT analysis"]オプションを選択します。[Add/Delete Curves] ダイアログの[EMI Standard]タブから、対応する EMI 標準をディスプレイに追加します。この 場合、以下に示すように、CISPR22 クラス B が追加されます。



展開された結果の表示を以下に示します。



CM 信号と DM 信号の周波数と振幅の値、および対応する EMI 標準レベルを、対象のポイント、つまり、最も低い周波数と最も高いノイズレベルで測定します。EMI 規格を上回っています。次に、 それらをパラメータパネルの「Common - Mode EMI」および「Differential - Mode EMI」セクションに入力します。この例では、最高の CM ノイズレベルは 81 dBuV で、最高の DM ノイズレベル は 81.5 dBuV です。 それらは両方とも 200 kHz の周波数で発生します。 EMI 標準は 63.6 dBuV です。

また、パラメータ・パネルで、EMI_filter_enable を1に設定して、EMI フィルタを有効にしま

す。1 段または2 段の EMI フィルタ・タイプを選択し、X-Cap および Y-Cap の初期容量値を選択 します。X-Cap 容量値の選択は、主に CM インダクタから得られる漏れインダクタンスの値に依 存します。Y-Cap の容量値の選択は、主にグランド・リーケージ電流の安全要件と CM インダク タンスの実際の値に依存します。

これらの値を入力したら、[Design EMI Filter]タブをクリックして、パラメーター・ファイル parameters-EMI.txt を更新します。parameters - EMI.txt を開き、[Edit] >> [Show Values] を選択して、CM および DM EMI フィルターのインダクタンス値をチェックし、それらが妥当で実 用的であることを確認します。それらが合理的または実用的でない場合は、X-Cap および Y-Cap の容量値を調整します。

この例では、Y-Cap は Cy = 100nF として選択され、コモンモード・インダクタンス L_cm = 49uH および漏れインダクタンス L_leakage = 2.4uH のコモンモード・インダクタ設計になり、CM ノ イズ(81 dBuV)などの適切な CM ノイズ減衰を提供します。200 kHz の周波数で EMI 規格(63.6 dBuV) を下回っています。

X-Cap が Cx = 6.8uF として選択されている場合、CM インダクタの漏れインダクタンス L_leakage = 2.4uH は、DM ノイズ(81.5 dBuV) が周波数で EMI 標準(63.6 dBuV) を下回るように適切な DM ノイズ減衰に十分です。 200 kHz の。 たとえば、X-Cap が Cx = 1.0uF として選択されてい る場合、適切な DM ノイズ減衰のために、L_dm = 2.5uH の外部 DM インダクタを挿入する必要が あるため、設計はあまり望ましくありません。

EMI フィルターが設計され、フィルター段数が決定されたら、パラメーター・パネルで、[EMI Filter Attenuation]ボタンをクリックして、以下に示すように、設計された EMI フィルターか らの CM および DMEMI ノイズ減衰を表示します。



この図では、dB(H_CM)はCMノイズの減衰を示し、dB(H_DM)はDMノイズの減衰をdB単位で 示しています。 このツールは、設計されたEMIフィルターがさまざまな周波数のノイズに与え る減衰量をすばやく計算するための便利な方法を提供します。 EMIデザイン・スイートの大きな利点の1つは、EMIフィルターのパラメーターが特定のEMI規

格に対して自動的に計算されるため、ユーザーが EMI フィルターを設計する手間を省くことができることです。

ステップ3:EMI フィルターを有効にしてシミュレーションを実行する 設計されたEMI フィルターを有効にしてシミュレーションを実行します。シミュレーションが完 了したら、CM / DM EMI 信号を調べて、EMI 標準レベルを下回っていることを確認します。そう でない場合は、満足のいく結果が得られるまで、さまざまなパラメーターを使用してステップ2 を繰り返します。



2. その他のデザインテンプレート

EMI プリ・コンプライアンスを設定するための他ののコンバータのテンプレートを以下に説明します。

2.1 昇圧コンバーター・テンプレート

次の図は、昇圧コンバータ・デザイン・テンプレートを示しています。このテンプレートでは、 非絶縁型昇圧コンバータが 500W の負荷電力で 160 Vdc 入力を 320 Vdc 出力電圧に昇圧します。 スイッチング周波数は 200 kHz です。 EMI 規格 MIL-461440V は、EMI 準拠に使用されます。 MIL-461EMI 標準の最低周波数は 10kHz であることに注意してください。



2.2 カ率補正 (PFC) コンバータ・テンプレート

次の図は、PFC コンバータ・テンプレートを示しています。 このテンプレートでは、PFC 昇圧コ ンバータが 200 Vac 入力を 576 W の負荷電力で 288 Vdc 出力に変換します。スイッチング周波数 は 200kHz です。EMI 規格 FCCCIass-B は、EMI コンプライアンスに使用されます。



2.3 位相シフト・フルブリッジ(PSFB) DC-DC コンバータテンプレート 次の図は、PSFB コンバーター・テンプレートを示しています。 このテンプレートでは、PSFB コンバーターは 30kW の負荷電力で 720 Vdc 入力を 400 Vdc 出力に変換します。スイッチング周 波数は 140 kHz です。EMI 規格 CISPR25 レベル 4 は、EMI コンプライアンスに使用されます。



2.4 PMSM ドライブ・テンプレート

次の図は、PMSM ドライブ・テンプレートを示しています。 このテンプレートでは、PMSM インバ ーターが 500 Vdc 入力を変換して、PMSM モーターを 5 Nm の負荷トルクで 170 Rad / s の速度に 駆動します。スイッチング周波数は 10 kHz です。EMI 規格 CISPR25 レベル 4 は、EMI コンプライ アンスに使用されます。



2.5 汎用 EMI 設計テンプレート

EMI デザイン・スイートは、一般的な EMI 設計テンプレートも提供します。これにより、ユーザ ーは EMI プリ・コンプライアンス・シミュレーション用に独自のパワー・エレクトロニクス・コ ンバータ回路を使用してシミュレーションすることができます。次の図は、一般的な EMI 設計テ ンプレートを示しています。 このテンプレートでは、EMI プリ・コンプライアンス・シミュレ ーション用のユーザーのパワー・エレクトロニクス・コンバータ回路に不可欠な EMI テスト機器 モデルが提供されています。

Technical Note 04410_T9_109



ご注意

- 1. 本資料に記載された製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
- 本資料の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不明な点などがあり ましたら、弊社までお申しつけください。
- 3. 本資料に記載された情報に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関して は、弊社は一切の責任を負いません。
- 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するもので はありません。
- 5. 弊社の書面許諾なく、本資料の一部または全部を無断で複製することを固くお断 りします。
- 6. 本資料に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright 2021 by Myway Corporation

All rights reserved. No part of this manual may be photocopied or reproduced in any form or by any means without the written permission of Myway Corporation.

発行: Myway プラス株式会社 〒220-0022 横浜市西区花咲町 6-145 横浜花咲ビル TEL:045-548-8836 FAX:045-548-8832

ホームページ:<u>https://www.myway.co.jp</u> Eメール: sales@myway.co.jp